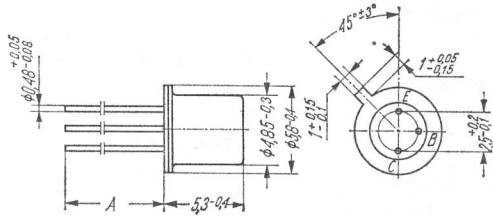


BC527 BC528



Rys. 1-325. BC527, 528

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: UNITRA-CEMI

Wykonanie: tranzystor krzemowy epi-taksjalno-planarny *n-p-n* w obudowie TO-18, kolektor połączony z obudową

Zastosowanie: układy wejściowe i sterujące m.cz.

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
I_{CB0} (BC 527)		1	30	nA	przy $U_{CB0} = 45$ V
I_{CB0} (BC 528)		1	30	nA	przy $U_{CB0} = 20$ V
$U_{(BR)CE0}$ (BC 527)	45	70		V	przy $I_{CE0} = 2$ mA
$U_{(BR)CE0}$ (BC 528)	20	35		V	przy $I_{CE0} = 2$ mA
$U_{(BR)EBO}$	5	10		V	przy $I_{EBO} = 10$ μ A
U_{BEsat}		0,1	0,25	V	przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 0,5$ mA
U_{CEsat}		0,72		V	przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 0,5$ mA
h_{21E} (I)	50	70			przy $I_C = 100$ μ A, $U_{CE} = 5$ V
(II)	80	100			
(III)	150	170			
h_{21E} (I)		120			przy $I_C = 2$ mA, $U_{CE} = 5$ V
(II)		200			
(III)		330			
h_{21E} (I)		200			przy $I_C = 20$ mA, $U_{CE} = 5$ V
(II)		300			
(III)		400			
F		5,5	10	dB	przy $I_C = 0,2$ mA, $U_{CE} = 5$ V, $R_r = 500$ Ω , $f_p = 1$ kHz, $\Delta f = 700$ Hz
C_{CB0}		2,7	4,5	pF	przy $I_C = 0$, $f_p = 5$ MHz, $U_{CB} = 10$ V
C_{EBO}			9	pF	przy $I_C = 0$, $f_p = 5$ MHz, $U_{EB} = 0,5$ V
f_T	150	400		MHz	przy $I_C = 10$ mA, $U_{CE} = 5$ V, $f_p = 100$ MHz
h_{11e} (I)	1,6		3,5	k Ω	przy $I_C = 2$ mA, $U_{CE} = 5$ V, $f_p = 1$ kHz
(II)	2,7		7	k Ω	
(III)	5		15	k Ω	
h_{12e} (I)		1,5		10^{-4}	przy $I_C = 2$ mA, $U_{CE} = 5$ V, $f_p = 1$ kHz
(II)		2		10^{-4}	
(III)		3		10^{-4}	
h_{21e} (I)	100		240		przy $I_C = 2$ mA, $U_{CE} = 5$ V, $f_p = 1$ kHz
(II)	210		450		
(III)	400		900		
h_{22e} (I)		20		μ S	przy $I_C = 2$ mA, $U_{CE} = 5$ V, $f_p = 1$ kHz
(II)		70		μ S	
(III)		150		μ S	

¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

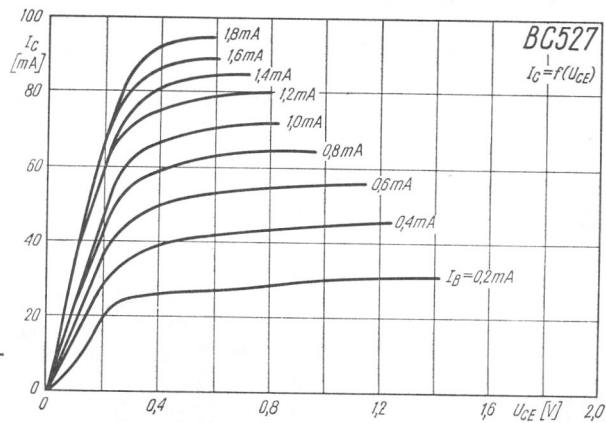
BC527 BC528

Wartości graniczne¹⁾

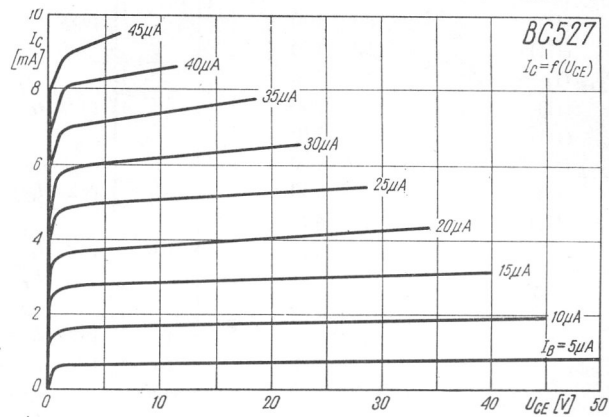
	BC527	BC528		I_B max	5	5	mA
U_{CB} max	45	20	V	P_{tot} max	300	300	mW
U_{CE} max	45	20	V	t_j max	150	150	°C
U_{EB} max	5	5	V	t_{stg}	-55 ÷ +150		°C
I_C max	50	50	mA	I_{CM} max	200	200	mA

¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

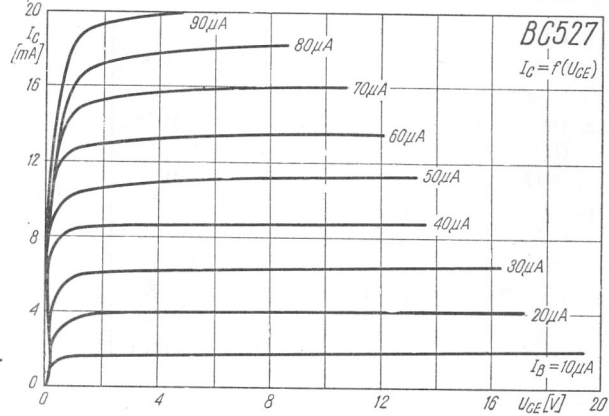
Rys. 1-326. Charakterystyki wyjściowe

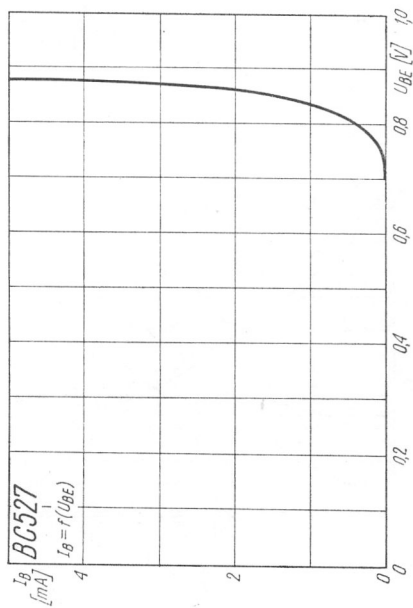


Rys. 1-327. Charakterystyki wyjściowe

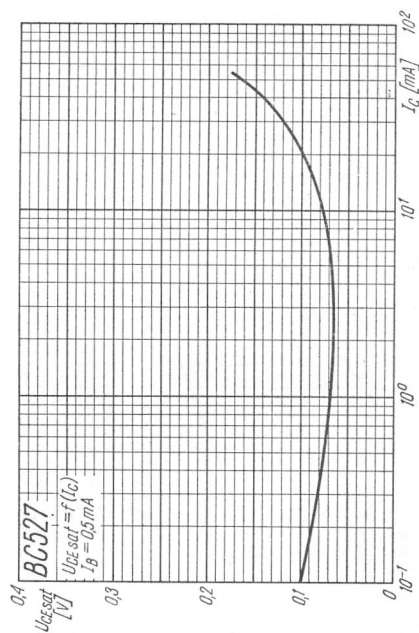


Rys. 1-328. Charakterystyki wyjściowe

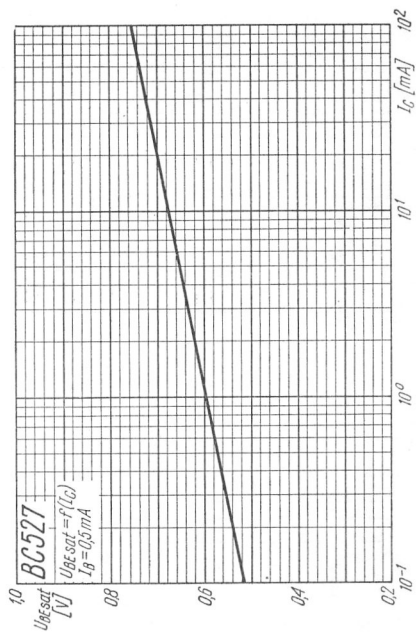




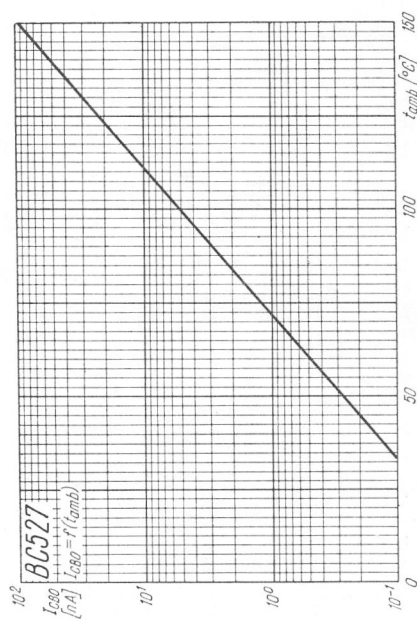
Rys. 1-329. Charakterystyka wejściowa



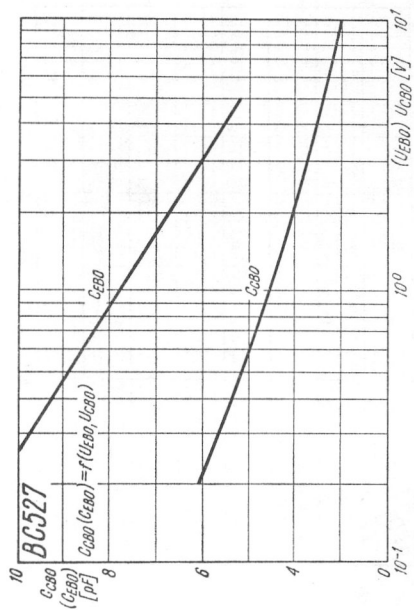
Rys. 1-330. Zależność napięcia nasycenia kolektora od prądu kolektora



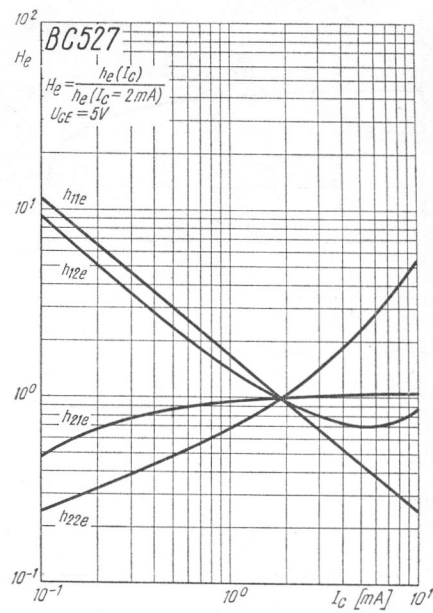
Rys. 1-331. Zależność napięcia nasycenia bazy od prądu kolektora



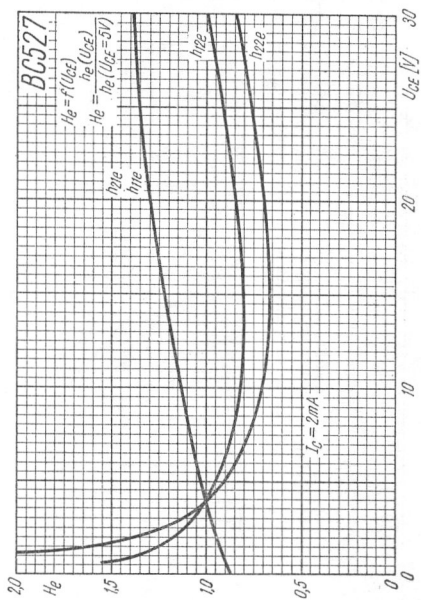
Rys. 1-332. Zależność prądu zerowego kolektora do temperatury otoczenia



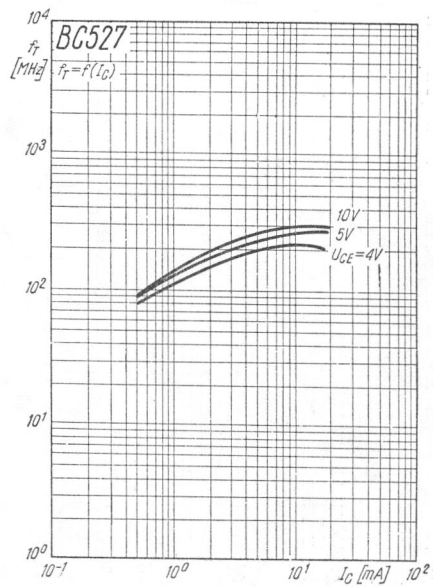
Rys. 1-333. Zależność napięciowa pojemności tranzystora



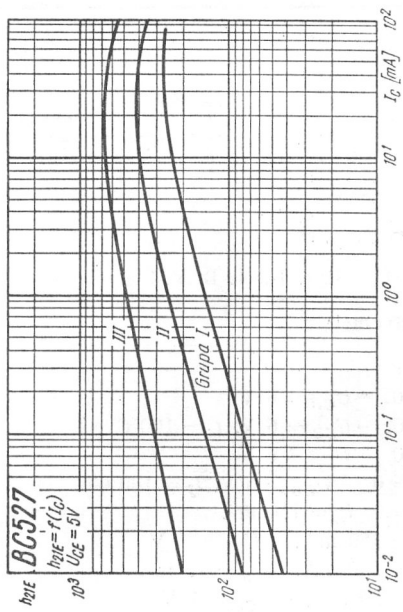
Rys. 1-334. Zależność parametrów h od prądu kolektora



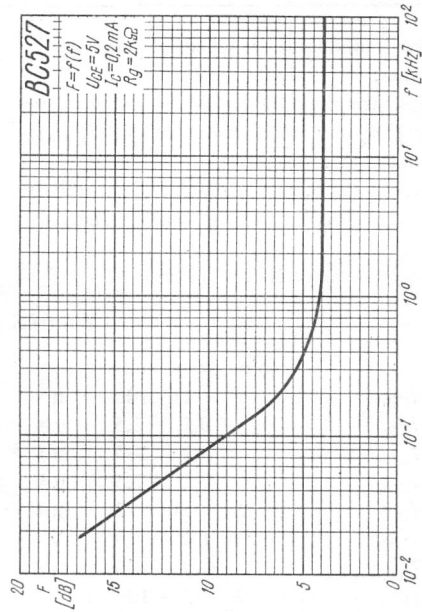
Rys. 1-335. Zależność parametrów h od napięcia kolektor-emitery



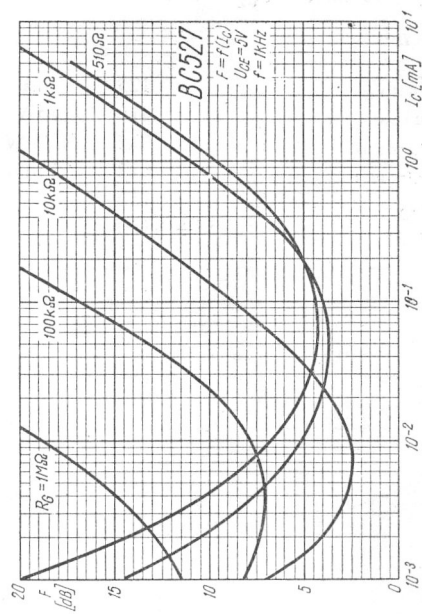
Rys. 1-336. Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora



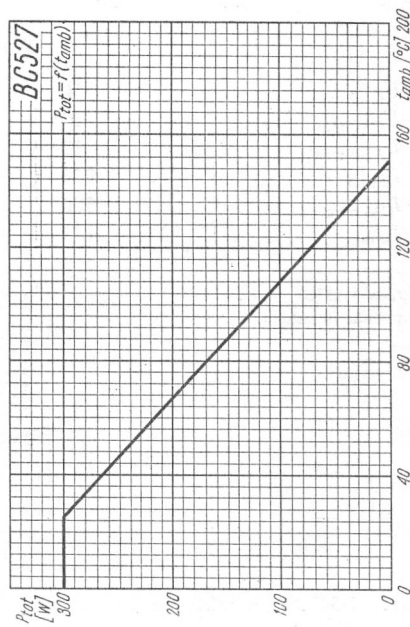
Rys. 1-337. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



Rys. 1-338. Zależność współczynnika szumów od częstotliwości



Rys. 1-339. Zależność współczynnika szumów od prądu kolektora



Rys. 1-340. Zależność całkowitej mocy strat od temperatury otoczenia